PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11-168185

(43) Date of publication of application: 22.06.1999

(51) Int. CI.

H01L 27/10 H01L 21/60 H01L 25/065

H01L 25/07

H01L 25/18 H03K 19/173

(21) Application number : **09-333376**

(71) Applicant: ROHM CO LTD

(22) Date of filing:

03. 12. 1997

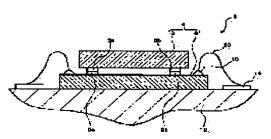
(72) Inventor: AKIYAMA MASUKUNI

(54) LAMINATED SUBSTRATE BODY AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a semiconductor device which is able to realize intended function in a short delivery time and has the high degree of integration.

SOLUTION: A laminated chip 4 is constituted by means of bonding pads 8a, 8b,... of a first chip 8 and pads 6a, 6b,... of a second chip 6. In the first chip 8, a field programmable gate array FPGA is formed. In the second chip 6, a central processing unit CPU is formed. An LSI 2 is used as a controller for controlling, e.g. an outer device. In this case, the FPGA functions as an interface circuit for linking the CPU with the outer device. By changing the FPGA program, the intended interface circuit corresponding to the outer device can be obtained. Furthermore through the use of the laminated chip 4, this kind of controller the requirement for space saving of which is large, can be made compact.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 24. 10. 2000

[Date of sending the examiner's decision 21.04.2003

of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's 2003-08690 decision of rejection]
[Date of requesting appeal against 15.05.2003 examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

京都府京都市右京区西院灣崎町21番地 口

ーム株式会社内 (74)代理人 弁理士 古谷 栄男 (外3名)

特開平11-168185

(43)公開日 平成11年(1999)6月22日

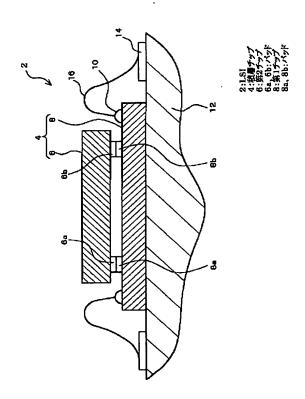
(51) Int.Cl. ⁶		識別記号		FI					
HOIL	27/10	495		H01	LL	27/10		495	
	21/60	3 1 1				21/60		3 1 1 S	
	25/065			H03	3 K	19/173		101	
	25/07			H01L	l L	25/08	В		
	25/18								
			審查請求	未請求	於 簡	改項の数11	OL	(全 12 頁)	最終頁に続く
(21)出願番		特願平9-33337 6		(71)	出顧人	、 000116024 ローム株式会社			
(22)出顧日		平成9年(1997)12月3日						一 右京区西院灣	崎町21番地
				(72)	発明	督 秋山	益國		

(54) 【発明の名称】 積層基板体および半導体装置

(57)【要約】

【課題】 短納期で所望の機能を実現することができ、 かつ、集積度の高い半導体装置を提供する。

【解決手段】 第1チップ8のパッド8a, 8b, ・・ ·と第2チップ6のパッド6a, 6b, · · · とを接合 することにより、積層チップ4を構成している。第1チ ップ8にはFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲ ート・アレー)が形成され、第2チップ6にはCPU (中央処理ユニット)が形成されている。LSI2は、 たとえば外部機器を制御するコントローラとして使用さ れる。この場合FPGAは、CPUと外部機器とを連結 するインタフェース回路として機能する。FPGAのプ ログラムを変更することで、外部機器に対応した所望の インタフェース回路を得ることができる。また、積層チ ップ4を用いることで、省スペースの要求が大きいこの 種のコントローラをコンパクトにすることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 あらかじめ用意された複数の回路要素相互 をプログラム可能なスイッチ手段を用いて継断すること により所望の機能を取得するプログラム可能な第1の機 能部と、第1の機能部に対応する第1の入出力端子と、 を有する第1の基板と、

1

第1の機能部に関連する機能を備えた第2の機能部と、 第2の機能部に対応する第2の入出力端子と、を有する 第2の基板と、

を備え、

第1の入出力端子と第2の入出力端子とが電気的に接続 されるように、第1の基板と第2の基板とを積層したこ

を特徴とする積層基板体。

【請求項2】請求項1の積層基板体において、

前記第2の機能部が、外部機器を制御する機能を備えて おり、

前記第1の機能部が、第2の機能部と当該外部機器とを 連結するインタフェース機能を備えていること、 を特徴とするもの。

【請求項3】請求項1の積層基板体において、

前記第2の機能部が、情報を記憶する機能を備えてお

前記第1の機能部が、第2の機能部に記憶された情報に 関連する処理を行なう機能を備えていること、 を特徴とするもの。

【請求項4】請求項1の積層基板体において、

前記第2の機能部が、アナログ処理を行なう機能を備え

前記第1の機能部が、第2の機能部で行なわれるアナロ グ処理に関連するディジタル処理を行なう機能を備えて いること、

を特徴とするもの。

【請求項5】請求項1の積層基板体において、

前記第2の機能部が、前記第1の機能部を制御する機能 を備えていること、

を特徴とするもの。

【請求項6】請求項1ないし請求項5のいずれかの積層 基板体において、

電源からの電力を前記第1の基板に供給するとともに、 第1の基板を介して前記第2の基板に電力を供給するよ う構成したこと、

を特徴とするもの。

【請求項7】情報を記憶する機能を備えた第1の機能部 と、第1の機能部に対応する第1の入出力端子と、を有 する第1の基板と、

第1の機能部を制御する機能を備えた第2の機能部と、 第2の機能部に対応する第2の入出力端子と、を有する 第2の基板と、

を備え、

第1の入出力端子と第2の入出力端子とが電気的に接続 されるように、第1の基板と第2の基板とを積層したこ

を特徴とする積層基板体。

【請求項8】請求項1ないし請求項7のいずれかの積層 基板体において、

前記第1の基板および第2の基板が、ともに高電圧ライ ンを備えており、

第1の基板の高電圧ラインの電圧と第2の基板の高電圧 10 ラインの電圧とが実質的に同一になるよう構成したこ 上.

を特徴とするもの。

【請求項9】請求項8の積層基板体において、

前記第1の基板の高電圧ラインと第2の基板の高電圧ラ インとを電気的に接続するための第1の入出力端子と第 2の入出力端子との対を複数組設けるよう構成したこ と、

を特徴とするもの。

【請求項10】請求項1ないし請求項9のいずれかの積 20 層基板体において、

前記第1の基板または第2の基板の一方に、当該積層基 板体の外部に対する入力または出力を行なう外部用端子 を設け、

前記外部用端子が設けられた基板に属する前記第1の入 出力端子または第2の入出力端子のいずれかと、当該外 部用端子とを電気的に接続するよう構成したこと、 を特徴とするもの。

【請求項11】請求項1ないし請求項10のいずれかの 積層基板体を備えたこと、を特徴とする半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は基板および半導体 装置に関し、特に、基板を積層した積層基板体および積 層基板体を備えた半導体装置に関する。

[0002]

【従来の技術】ユーザーが手元で論理機能を書込むこと ができるLSIとして、PLD (Programmable Logic D evice) が知られている。 PLDには、AND平面とO R平面とを基本構造とする小規模なPLA(Programmab 40 le Logic Array)から、大規模なFPGA(Field Prog rammable Gate Array)にいたるまで、多くの種類があ る。

【0003】これらは、いずれも、あらかじめチップ上 に多くの論理回路等を配置するとともに、論理回路等相 互を、プログラム可能なスイッチを介して接続し得るよ う構成したものである。したがって、ユーザーが、これ ら多くのスイッチを所定のパタンにしたがって継断する ことにより、所望の論理機能を実現することができる。 すなわち、PLDを用いることにより、短納期で、所望 50 の論理機能を有するLSIを実現することができる。

【0004】このため、たとえば、機器を制御するマイクロコンピュータシステムのインタフェース回路として、PLDが用いられる。マイクロコンピュータシステムにおいては、制御対象となる機器に対応した専用のインタフェース回路が必要となるが、PLDを用いることにより、短納期で、種々の機器に対応した所望のインタフェース回路を実現することができる。

3

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記のような 従来のPLDには、次のような問題点があった。従来の PLDは一つの独立したパッケージにより構成されてい るため、たとえば、上述のマイクロコンピュータシステ ムに用いた場合、インタフェース回路だけで一つのパッ ケージが必要となる。これでは、マイクロコンピュータ システムの集積度を上げることができない。

【0006】この発明はこのような問題点を解決し、短納期で所望の機能を実現することができ、かつ、集積度の高い半導体装置を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】請求項1の積層基板体は、あらかじめ用意された複数の回路要素相互をプログラム可能なスイッチ手段を用いて継断することにより所望の機能を取得するプログラム可能な第1の機能部に対応する第1の入出力端子と、を有する第1の機能部に対応する第2の機能部と、第2の機能部に対応する第2の入出力端子と、を有する第2の基板と、を備え、第1の入出力端子と第2の入出力端子とが電気的に接続されるように、第1の基板と第2の基板とを積層したこと、を特徴とする。

【0008】請求項2の積層基板体は、請求項1の積層 基板体において、前記第2の機能部が、外部機器を制御 する機能を備えており、前記第1の機能部が、第2の機 能部と当該外部機器とを連結するインタフェース機能を 備えていること、を特徴とする。

【0009】請求項3の積層基板体は、請求項1の積層 基板体において、前記第2の機能部が、情報を記憶する 機能を備えており、前記第1の機能部が、第2の機能部 に記憶された情報に関連する処理を行なう機能を備えて いること、を特徴とする。

【0010】請求項4の積層基板体は、請求項1の積層 基板体において、前記第2の機能部が、アナログ処理を 行なう機能を備えており、前記第1の機能部が、第2の 機能部で行なわれるアナログ処理に関連するディジタル 処理を行なう機能を備えていること、を特徴とする。

【0011】請求項5の積層基板体は、請求項1の積層 基板体において、前記第2の機能部が、前記第1の機能 部を制御する機能を備えていること、を特徴とする。

【0012】請求項6の積層基板体は、請求項1ないし 請求項5のいずれかの積層基板体において、電源からの 電力を前記第1の基板に供給するとともに、第1の基板 を介して前記第2の基板に電力を供給するよう構成した こと、を特徴とする。

【0013】請求項7の積層基板体は、情報を記憶する機能を備えた第1の機能部と、第1の機能部に対応する第1の入出力端子と、を有する第1の基板と、第1の機能部を制御する機能を備えた第2の機能部と、第2の機能部に対応する第2の入出力端子と、を有する第2の基板と、を備え、第1の入出力端子と第2の入出力端子とが電気的に接続されるように、第1の基板と第2の基板とを積層したこと、を特徴とする。

【0014】請求項8の積層基板体は、請求項1ないし 請求項7のいずれかの積層基板体において、前記第1の 基板および第2の基板が、ともに高電圧ラインを備えて おり、第1の基板の高電圧ラインの電圧と第2の基板の 高電圧ラインの電圧とが実質的に同一になるよう構成し たこと、を特徴とする。

【0015】請求項9の積層基板体は、請求項8の積層 基板体において、前記第1の基板の高電圧ラインと第2 20 の基板の高電圧ラインとを電気的に接続するための第1 の入出力端子と第2の入出力端子との対を複数組設ける よう構成したこと、を特徴とする。

【0016】請求項10の積層基板体は、請求項1ない し請求項9のいずれかの積層基板体において、前記第1 の基板または第2の基板の一方に、当該積層基板体の外 部に対する入力または出力を行なう外部用端子を設け、 前記外部用端子が設けられた基板に属する前記第1の入 出力端子または第2の入出力端子のいずれかと、当該外 部用端子とを電気的に接続するよう構成したこと、を特 30 徴とする。

【0017】請求項11の半導体装置は、請求項1ない し請求項10のいずれかの積層基板体を備えたこと、を 特徴とする。

【0018】なお、上記各請求項における「回路要素」とは、回路を構成する要素をいい、たとえば、論理素子、遅延素子、記憶素子、演算回路、配線など、あらゆる素子や回路を含む概念である。実施形態では、図3のデータ入力ラインL11、・・・やAND入力ラインL21、・・・等が、これに該当する。

40 【0019】「入出力端子」とは、なんらかの入力または出力を行なう端子をいい、たとえば、信号や電力の供給を受ける入力専用端子、供給するための出力専用端子、入出力兼用端子などを含む概念である。実施形態では、図1のパッド8a,8b,・・・やパッド6a,6b,・・・が、これに該当する。

[0020]

【発明の作用および効果】請求項1の積層基板体および 請求項11の半導体装置は、プログラム可能な第1の機 能部と第1の入出力端子とを有する第1の基板と、第1 の機能部に関連する機能を備えた第2の機能部と第2の 入出力端子とを有する第2の基板とを備え、第1の入出力端子と第2の入出力端子とが電気的に接続されるように、第1の基板と第2の基板とを積層したことを特徴とする。

【0021】したがって、第1の機能部の機能を、第2の機能部や外部機器に対応させて柔軟に変更することができる。このため、新たな専用ICをつくることなく第1の機能部の機能を実現することができる。また、第1の基板と第2の機能部の機能とをともに備えた小さい投 10 影面積を有する半導体装置を実現することができる。さらに、第1の基板と第2の基板とを多数積層することで、多数のICを用いて構成していた複雑なシステムを、一つの半導体装置で実現することができる。このため、このようなシステムを低コストで、かつ、コンパクトに実現することが可能となる。

【0022】すなわち、短納期で所望の機能を実現することができ、かつ、集積度の高い安価な半導体装置を得ることができる。

【0023】請求項2の積層基板体は、第2の機能部が外部機器を制御する機能を備えており、第1の機能部が、第2の機能部と当該外部機器とを連結するインタフェース機能を備えていることを特徴とする。

【0024】したがって、たとえば、積層基板体を外部機器の制御装置に使用した場合、外部機器に対応させて柔軟にインタフェース機能を変更することができる。また、積層基板体を用いることで、省スペースの要求が大きい制御装置をコンパクトにすることができる。

【0025】請求項3の積層基板体は、第2の機能部が 情報を記憶する機能を備えており、第1の機能部が、第 2の機能部に記憶された情報に関連する処理を行なう機 能を備えていることを特徴とする。

【0026】したがって、たとえば、積層基板体をDSP(ディジタル・シグナル・プロセッサ)に使用した場合、第2の機能部をRAM(ランダム・アクセス・メモリ)として用いるとともに、信号処理の内容に対応させて柔軟に第1の機能部の機能を変更することができる。また、積層基板体を用いることで、コンパクトなDSPを得ることができる。

【0027】請求項4の積層基板体は、第2の機能部がアナログ処理を行なう機能を備えており、第1の機能部が、第2の機能部で行なわれるアナログ処理に関連するディジタル処理を行なう機能を備えていることを特徴とする。

【0028】したがって、たとえば、積層基板体を、PLL(位相同期ループ)回路を用いた周波数シンセサイザに使用した場合、第2の機能部をVCO(電圧制御発信回路)として用いるとともに、第1の機能部を、VCOの出力を分周する分周回路として用いることができる。この場合、出力すべき周波数に対応させて柔軟に分 50

周回路を変更することができる。また、積層基板体を用いることで、コンパクトな周波数シンセサイザを得ることができる。

6

【0029】請求項5の積層基板体は、第2の機能部 が、前記第1の機能部を制御する機能を備えていること を特徴とする。

【0030】したがって、たとえば、第2の機能部を、第1の機能部をプログラムするための書込み装置として用いた場合、外部の書込み装置を必要としないPLDを実現することができる。

【0031】請求項6の積層基板体は、電源からの電力を第1の基板に供給するとともに、第1の基板を介して第2の基板に電力を供給するよう構成したことを特徴とする。

【0032】したがって、第1の機能部に対するプログラムの書込みや消去に高電圧を要する第1の基板には、電源から低電圧電力とともに高電圧電力を供給し、高電圧を要しない第2の基板には、第1の基板を介して低電圧電力のみを供給することが可能となる。このため、第1の基板のみを高耐圧仕様とすれば十分である。すなわち、第2の基板は低耐圧仕様とすることができるので、第2の基板を構成する回路要素の集積度を上げることができる。

【0033】請求項7の積層基板体は、情報を記憶する機能を備えた第1の機能部と第1の入出力端子とを有する第1の基板と、第1の機能部を制御する機能を備えた第2の機能部と第2の入出力端子とを有する第2の基板とを備え、第1の入出力端子と第2の入出力端子とが電気的に接続されるように第1の基板と第2の基板とを積30層したことを特徴とする。

【0034】したがって、たとえば、第2の機能部を、第1の機能部に対する情報の書込み装置として用いた場合、外部の書込み装置を必要としない情報記憶装置を実現することができる。また、第1の基板と第2の基板とを積層することで、情報を記憶する機能と例えば情報を書込む機能とをともに備えた小さい投影面積を有する情報記憶装置を実現することができる。

【0035】請求項8の積層基板体は、第1の基板および第2の基板がともに高電圧ラインを備えており、第1 40 の基板の高電圧ラインの電圧と第2の基板の高電圧ラインの電圧とが実質的に同一になるよう構成したことを特徴とする。

【0036】したがって、第1の入出力端子と第2の入出力端子とを電気的に接続することにより、第1の基板の高電圧ラインと第2の基板の高電圧ラインとを、双方の基板で共用することができる。このため、高電圧用の配線等に必要なスペースを節約することができる。

【0037】請求項9の積層基板体は、第1の基板の高電圧ラインと第2の基板の高電圧ラインとを電気的に接続するための第1の入出力端子と第2の入出力端子との

対を複数組設けるよう構成したことを特徴とする。

【0038】したがって、第1の入出力端子と第2の入出力端子とを接続する際の接続抵抗が大きい場合であっても、複数の接続箇所を設けることで該接続抵抗を減少させることができる。

【0039】請求項10の積層基板体は、第1の基板または第2の基板の一方に外部用端子を設け、外部用端子が設けられた基板に属する第1の入出力端子または第2の入出力端子のいずれかと、当該外部用端子とを電気的に接続するよう構成したことを特徴とする。

【0040】したがって、たとえば、第1の基板に外部 用端子を設けた場合、当該外部用端子と第2の基板の第 2の入出力端子とを、第1の基板の第1の入出力端子を 介して、電気的に接続することができる。このため、外 部用端子が設けられていない第2の基板と、外部用端子 との間で、電力や信号の授受を直接行なうことが可能と なる。

[0041]

【発明の実施の形態】図1に、この発明の1実施形態による半導体装置であるLSI(高密度集積回路)2の断面構成を示す。LSI2は、パッケージ12の上に、積層基板体である積層チップ4を載置して固定した構成を有している。積層チップ4は、第1の基板である第1チップ8および第2の基板である第2チップ6を積層して一体化したチップである。

【0042】図2に、積層チップ4の分解斜視図を示す。第1チップ8および第2チップ6は、いずれも半導体により構成されたICチップである。この実施形態においては、第1チップ8には、プログラム可能な第1の機能部として、FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレー)が形成されており、第2チップ6には、第2の機能部として、CPU(中央処理ユニット)が形成されている。

【0043】第1チップ8は、上面に第1の入出力端子である複数のパッド8a,8b,・・・を備えている。この実施形態においては、パッド8a,8b,・・・は、FPGAに対する入出力を行なうためのパッドである。また、第1チップ8の上面の外周近傍には、外部に対する入出力を行なうための複数のパッド10(外部用端子)が設けられている。

【0044】第2チップ6は、下面に第2の入出力端子である複数のパッド6a,6b,・・・を備えている。この実施形態においては、パッド6a,6b,・・・は、CPUに対する入出力を行なうためのパッドである。

【0045】各パッド8a,8b,・・・とパッド6a,6b,・・・とは、互いに対向する位置に設けられている。互いに対抗する位置に設けられたパッド8a,8b,・・・とパッド6a,6b,・・・との一方を、たとえば金(Au)で形成し、他方を、たとえば錫(S

u) で形成することで、共晶を利用したバンプ技術により、パッド8a, 8b, ・・・とパッド6a, 6b, ・・・とを接合している。

【0046】このようにして形成された積層チップ4は、図1に示すように、パッケージ12の上に載置して固定される。パッケージ12に設けられたパッド14と、第1チップ8に設けられたパッド10とは、ボンディングワイヤ16により接続される。なお、積層チップ4およびボンディングワイヤ16は、エポキシ樹脂等を10用いた封止部材(図示せず)により封止されている。

【0047】この実施形態においては、LSI2は、外部機器を制御するコントローラとして使用される。すなわち、第2チップ6に形成されたCPU(図示せず)を用いて、外部機器の制御を行なう。外部機器は、パッケージ12に設けられたパッド14に電気的に接続される。第1チップ8に形成されたFPGAは、CPUと外部機器とを連結するインタフェース回路として機能する。

【0048】したがって、FPGAのプログラムを変更 20 することで、外部機器に対応した所望のインタフェース 回路を得ることができる。このため、新たな専用インターフェース回路を持つICをつくることなく所望のイン タフェース回路を実現することができる。すなわち、新たな専用ICを開発したり、専用ICのための製造工程を別途設けたりする必要がない。

【0049】また、積層チップ4を用いることで、省スペースの要求が大きいこの種のコントローラをコンパクトに形成することができる。なお、この実施形態においては、外部機器を制御するためのプログラムは、ROM (読出専用メモリ)チップ (図示せず)として、LSI2の外部に配置され、パッケージ12に設けられたパッド14を介して、CPUに送られる。

【0050】また、LSI2の外部には電源(図示せず)が設けられており、当該電源から、パッド14を介して第1チップ8に電力が供給され、さらに第1チップ8を介して第2チップ6に電力が供給される。

【0051】したがって、FPGAに対するプログラムの書込みや消去に高電圧を要する第1チップ8には、電源から低電圧電力とともに高電圧電力を供給し、高電圧 を要しないCPUを搭載した第2チップ6には、第1チップ8を介して低電圧電力のみを供給することが可能となる。このため、第1チップ8のみを高耐圧仕様とすれば十分である。すなわち、第2チップ6は低耐圧仕様とすることができるので、CPUを搭載した第2チップ6の集積度を上げることができる。

【0052】図3に、第1チップ8に形成されたFPG Aを構成するロジックアレー20の回路構成の一例を模式的に示す。FPGAは、比較的複雑な構成のPLDであり、FPGAのロジックアレー20は、AND平面部 50 22とOR平面部24とを備えている。なお図3は、説

(6)

1٨

明のために、ロジックアレー20の回路構成の一部を抜き出して示した図であり、実際のロジックアレー20 は、より複雑な構成を持っている。

【0053】図3の例では、AND平面部22は、回路 要素である4本のデータ入力ラインL11、L12、L 13、L14、4本のAND入力ラインL21、L2 2、L23、L24、および、4個のANDゲートAN D1、AND2、AND3、AND4を備えている。

【0054】AND平面部22の、データ入力ラインL $11\sim$ L14とAND入力ラインL $21\sim$ L24との16個の交点には、プログラム可能なスイッチ手段であるスイッチSW $11\sim$ SW44が設けられている。

【0055】OR平面部24は、回路要素である4本のAND出力ラインL31、L32、L33、L34、3本のOR入力ラインL41、L42、L43、3個のORゲートOR1、OR2、OR3、および、3本のOR出力ラインL51、L52、L53を備えている。

【0056】AND平面部22同様、OR平面部24の、AND出力ラインL31~L34とOR入力ライン L41~L43との12個の交点には、プログラム可能なスイッチ手段であるスイッチSW51~SW83が設けられている。

【0057】なお、図3においては説明の便宜上、4個のANDゲートAND1、AND2、AND3、AND4と、3個のORゲートOR1、OR2、OR3とを用いるよう記載したが、実際の回路においては、これらのゲートに替え、7個のNANDゲートを用いて、図3と論理的に等価な回路を実現している。

【0058】図4A、図4B、図4Cに、プログラム可能なスイッチ手段(たとえば、スイッチSW11)の具体例を示す。スイッチSW11として、図4Aに示すヒューズを用いることができる。この場合、データ入力ラインL11とAND入力ラインL21とを切り離すには、このヒューズを焼切ればよい。

【0059】ヒューズの場合とは逆に、あらかじめ絶縁しておき、絶縁を破壊することによりデータ入力ラインL11とAND入力ラインL21とを導通させるよう構成したアンチヒューズ(図示せず)を、スイッチSW11として用いることもできる。 また、スイッチSW11として、図4Bに示すフラッシュメモリやEEPROM (Erectrically Erasable and Programmable Read Only Memory)を用いることもできる。EEPROMを用いることにより論理機能の書き換えが可能となる。

【0060】また、論理機能の書き換えをリアルタイムで行なわせるために、スイッチSW11として、図4Cに示すSRAM(Static Random Access Memory)を用いることもできる。

【0061】さらに、スイッチSW11として、強誘電体を用いたメモリを使用することもできる。強誘電体を用いたメモリを使用することにより、不揮発性で、か

つ、高速度で書換え可能なスイッチSW11を実現する ことができる。

【0062】図5に、強誘電体を用いたメモリを使用したスイッチSW11の回路構成の一例を示す。この例では、スイッチSW11は、強誘電体トランジスタ30を備えている。

【0063】ゲート端子Gとデータ入カラインL11との間に、所定の電圧を印加すると、強誘電体層FEは分極するが、印加する電圧の向きにより、強誘電体層FEの分極方向が異なる。強誘電体層FEの分極方向が異なると、同一のゲート電圧に対するドレイン電流の値が異なる。この性質を利用して、スイッチSW11の閉状態と開状態とを作り出すよう構成している。

【0064】ゲート端子Gとデータ入力ラインL11との間に印加する電圧の向きと、強誘電体層FEの分極方向との関係は、他の要素の影響を受けるため必ずしも固定されたものではないが、少なくとも同一条件下においては、同一の関係をもたらす。

【0065】したがって、たとえば、データ入力ライン L11に対して、ゲート端子Gが正となる向きの電圧を 印加すると、所定のゲート電圧に対し、しきい値以上の ドレイン電流が流れる方向に分極し、逆向きの電圧を印 加すると、所定のゲート電圧に対し、しきい値より小さ い値のドレイン電流しか流れない方向に分極したとすれ ば、前者がスイッチSW11の閉状態、後者がスイッチ SW11の開状態である。

【0066】このように、ゲート端子Gとデータ入カラインL11との間に印加する電圧の向きを替えることにより、スイッチSW11の継断データを、書き換えるこ30とができる。

【0067】なお、図5の例においては、ゲート端子Gとデータ入力ラインL11との間に印加する電圧の向きを替えることにより、強誘電体層FEの分極方向を異ならせるよう構成したが、強誘電体層FEのゲート端子Gと反対側の端部に電極端子を接続してこれをメモリゲート端子MGとし、ゲート端子Gとメモリゲート端子MGとの間に印加する電圧の向きを替えることにより、強誘電体層FEの分極方向を異ならせるよう構成することもできる。

0 【0068】また、スイッチSW11に使用するための 強誘電体を用いたメモリとしては、図5に示す強誘電体 トランジスタ30を備えたメモリ以外に、たとえば、強 誘電体コンデンサを備えたメモリ(図示せず)を使用す ることもできる。

【0069】なお、上述の実施形態においては、LSI2が、外部機器を制御するコントローラとして使用される場合を例に説明したが、この発明はこれに限定されるものではない。たとえば、LSI2が汎用のFPGAとして使用される場合にも、この発明を適用することがで50 きる。

【0070】この場合、第1チップ8には、前述の実施 形態と同様に、第1の機能部としてFPGAが形成され る。一方、第2チップ6には、第2の機能部として、F PGAへのプログラムの書込みや消去をおこなう書込み 回路を形成しておく。このようにすれば、外部の書込み 装置を必要としないFPGAを実現することができる。

【0071】また、LSI2をDSP(ディジタル・シグナル・プロセッサ)として使用する場合にも、この発明を適用することができる。LSI2をDSPとして用いるためには、第2チップ6に、第2の機能部として、RAM(ランダム・アクセス・メモリ)を形成しておく。

【0072】一方、第1チップ8には、前述の実施形態と同様に、第1の機能部としてFPGAを形成しておくが、この場合、FPGAが信号処理部として機能するようにプログラムしておく。

【0073】このように設定しておけば、FPGAは、第2チップ6に形成されたRAMから与えられた信号に所定の処理を施した後、LSI2外部に出力したり、LSI2外部から与えられた信号に所定の処理を施した後、第2チップ6に形成されたRAMに蓄積したりすることができる。

【0074】FPGAのプログラムを変更することで、信号処理の内容を容易に変更することができる。また、 積層チップ4を用いることで、コンパクトなDSPを実 現することができる。

【0075】また、たとえば、第1チップ8にFPGAを形成するとともに、第2チップ6にフラッシュメモリを形成するよう構成することもできる。この場合、第1チップ8のFPGAおよび第2チップ6のフラッシュメモリともに、書込み・消去のための高電圧ラインを必要とする場合がある。このような場合、FPGAの書込み・消去に要する電圧と、フラッシュメモリの書込み・消去に要する電圧とが同一になるよう設定しておくと好都合である。

【0076】電圧をこのように設定しておくと、第1チップ8および第2チップ6双方の高電圧ラインを、パッド8a,8b,・・・、6a,6b,・・・のいずれかを介して、当該双方のチップ間で共用することができる。このため、高電圧用の配線等に必要なスペースを節約することができる。

【0077】さらにこの場合、当該高電圧ラインを接続するためのパッドを、複数組形成しておけば、接続抵抗を小さくすることができ、好都合である。パッド8a,8b,・・・、6a,6b,・・・の接続方法として、上述のバンプ技術や、後述する異方性導電体を用いる場合には、接続抵抗が大きくなる傾向があるため、このように、接続点を並列に形成して接続抵抗を小さくすることが特に好ましい。

【0078】また、たとえば、LSI2を、PLL(位 50 b, \cdots とを電気的に接続することもできる。

相同期ループ)回路を用いた周波数シンセサイザとして使用することができる。この場合には、第2チップ6に、第2の機能部として、アナログ回路であるVCO(電圧制御発信回路)を形成しておく。

【0079】一方、第1チップ8には、前述の実施形態と同様に、第1の機能部としてFPGAを形成しておくが、この場合、FPGAが、VCOの出力を分周したのち再びVCOにフィードバックするような回路をとして機能するようにプログラムしておく。

 【0080】このように設定しておけば、LSI2を、 PLL回路を用いた周波数シンセサイザとして使用する ことができる。この場合、FPGAのプログラムを変更 することで、出力すべき周波数を容易に変更することが できる。また、積層チップ4を用いることで、コンパク トな周波数シンセサイザを得ることができる。

【0081】なお、このように、第2チップ6に、第2の機能部としてアナログ回路を搭載する場合、アナログ信号の授受が必要となるパッドは、バッファを介在しないパッドとしておくとよい。

20 【0082】また、この場合、第1チップ8に設けられたパッド10のいずれかと、たとえばパッド8aとを導通状態にしておく (スルーパッド) ことにより、パッド10と第2チップ6のパッド6aとを、パッド8aを介して電気的に接続することができる。このため、第2チップ6に外部用端子を直接設けることができない場合であっても、たとえば、第1チップ8に設けられたパッド10をアナログ信号の入出力端子として用いたり、パッド10をアナログ回路専用の電源端子として用いたりすることができ、好都合である。

30 【0083】上述の各実施形態においては、第1チップ8に、第1の機能部としてFPGAを形成した場合を例に説明したが、この発明はこれに限定されるものではない。たとえば、第1チップ8に、第1の機能部としてメモリ装置を形成するよう構成することができる。この場合、第2チップ6に、第2の機能部として、該メモリ装置に対するデータの書込みや消去を行なう書込み回路を形成しておくとよい。

【0084】このように構成すれば、外部の書込み装置を必要としない情報記憶装置を実現することができる。 40 また、第1チップ8と第2チップ6とを積層することで、情報を記憶する機能と情報を書込む機能とをともに備えた小さい投影面積を有する情報記憶装置を実現することができる。

【0085】なお、上述の各実施形態においては、図1に示すように、パッド8a,8b,・・・とパッド6a,6b,・・・とを電気的に接続する方法として、バンプ技術を用いた場合を例に説明したが、この発明はこれに限定されるものではない。たとえば、ハンダ技術を用いて、パッド8a,8b,・・・とパッド6a,6

【0086】また、図6に示すように、異方性導電体1 8を用いてパッド8a, 8b, · · · とパッド6a, 6 b, ・・・とを電気的に接続することもできる。 異方性 導電体10は、一方向にのみ導電性を有する導電体で、 接着性を有している。異方性導電体として、たとえば熱 硬化性の接着剤であるアニソルム (日立化成) を用いる ことができる。

【0087】このような異方性導電体18を用いること により、第1チップ8および第2チップ6を強固に接着 ップ8および第2チップ6を強固に接着することによ り、互いに対向する位置に設けられたパッド8a,8 b, ・・・とパッド6a, 6b, ・・・とが、電気的に 接続される。

【0088】また、上述の各実施形態においては、図1 に示すように、積層チップ4をパッケージ12に固定す るとともに、積層チップ4のパッド10とパッケージ1 2に設けられたパッド14とをボンディングワイヤ16 を用いて接続するよう構成したが、この発明はこのよう な構成に限定されるものではない。

【0089】たとえば、図7に示すように、積層チップ 4を、フィルム状の合成樹脂基板に直接、実装すること もできる。このように、積層チップ4を実装した基板 を、タブ (tab: tape automated bonding) 26とい う。タブ26にはプリント配線(図示せず)が施されて おり、プリント配線のパッド部(図示せず)と積層チッ プ4のパッド10とが接合される。なお、上述の各実施 形態の場合と同様に、積層チップ4は、エポキシ樹脂等 を用いた封止部材(図示せず)により封止されている。

【0090】また、図8に示すように、パッド10を第 1チップ8の下面(すなわち、パッド8a, 8b, ・・ ・の設けられた面の反対側の面)に設けることが可能な 場合には、積層チップ4を、タブ26の上面に積み上げ るように実装することもできる。

【0091】なお、上述の各実施形態においては、第1 チップ8に電力が供給され、さらに第1チップ8を介し て第2チップ6に電力が供給されるよう構成したが、こ の発明はこれに限定されるものではない。たとえば、第 2チップ6に電力が供給され、さらに第2チップ6を介 して第1チップ8に電力が供給されるよう構成すること もできる。また、第1チップ8と第2チップ6との配置 関係を上下逆にすることもできる。

【0092】また、上述の各実施形態においては、2つ のチップを重ねた積層チップ4を例に説明したが、3つ 以上のチップを重ねた積層チップにも、この発明を適用 することができる。

【0093】図9は、第1チップ8の上に、第2チップ 32および第3チップ34を横に並べて配置した構成を 有する積層チップ36を示す図面である。積層チップ3 6は、パッケージ12に載置されて固定されている。

【0094】たとえば、第1チップ8にFPGAを形成 してインタフェース回路の働きをするようプログラムし ておき、第2チップ32にCPUを形成するとともに、 第3チップ34にROMを形成すれば、一つの積層チッ プ36で、外部機器を制御するためのコントローラを実 現することができる。なお、この場合、第1チップ8が 第1の基板に該当し、第2チップ32および第3チップ 34が第2の基板に該当する。

14

【0095】図11は、第1チップ8(第1の基板に該 することができる。異方性導電体18を用いて、第1チ 10 当)の上に多数のチップ(第2の基板に該当)50a, 50b, · · · , 50gを、横に並べて配置した構成を 有する積層チップ52を示す分解斜視図である。

> 【0096】たとえば、図12に示すようなコンパクト ディスクシステム60を構成する各機能部、たとえば、 RFアンプ62、DSP64, DF·DAC66, CD -Gデコーダ68, RGBエンコーダ70, CDドライ バ72等を、それぞれ、図11のチップ50a, 50 b, ・・・, 50gとして形成するとともに、システム コントロールマイコン74および各チップ間の結線(図 20 示せず)などをFPGAとして第1チップ8に形成する ことができる。

【0097】なお、図12に示すコンパクトディスクシ ステム60は、従来、RFアンプ62、DSP64,D F·DAC66, CD-Gデコーダ68, RGBエンコ ーダ70,CDドライバ72、システムコントロールマ イコン74等の各機能部をそれぞれ、別のICとして形 成し、これらを、1枚のボードに搭載するよう構成して いた。したがって、コンパクト性に欠け、製造コストも 高かった。

【0098】図11のように構成すれば、従来、一つの ボードに複数のICを搭載することにより実現していた コンパクトディスクシステム60のような複雑なシステ ムを、一つの積層チップ52、すなわち、一つのICに より実現することができる。このため、複雑なシステム を、コンパクトかつ低コストで実現することができる。 【0099】図10は、第1チップ8の上に第2チップ 40を載せて固定するとともに、第2チップ40の上に 第3チップ42を載せて固定した構成を有する積層チッ

【0100】このように、接続すべきパッドをチップ (この例では第2チップ40)の下面および上面の双方 に設けることが可能な場合には、3層以上のチップを積 層することが容易になる。この場合、第1チップ8が第 1の基板に該当し、第2チップ40が第2の基板に該当

プ44を示す図面である。積層チップ44は、パッケー

40 ジ12に載置されて固定されている。

【0101】なお、チップが3層以上積層されている場 合、たとえば図10のような場合、第1チップ8と第3 チップ42とが、第2チップ40に設けられた配線(図 50 示せず)を介して電気的に接続されているような場合に は、第3チップ42も第2の基板に該当する。また、第 2チップ40が第1の基板に該当するような場合には、 第1チップ8および第3チップ42が、第2の基板に該 当する。

【0102】なお、上述の各実施形態においては、プログラム可能な第1の機能部の一例としてFPGAを例に説明したが、この発明はこれに限定されるものではない。たとえば、プログラム可能な第1の機能部としてPLDの一種であるPLA等を用いた場合にも、この発明を適用することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の1実施形態による半導体装置である LSI(高密度集積回路)2の断面構成を示す図面である。

【図2】積層チップ4の分解斜視図である。

【図3】第1チップ8に形成されたFPGAを構成するロジックアレー20の回路構成の一例を模式的に示した図面である。

【図4】図4A,図4B,図4Cは、プログラム可能なスイッチ手段の具体例を示す図面である。

【図5】強誘電体を用いたメモリを使用したスイッチS W11の回路構成の一例を示す図面である。 【図6】この発明の他の実施形態による積層チップの断面構成を示す図面である。

【図7】この発明の他の実施形態による積層チップの断面構成を示す図面である。

【図8】この発明の他の実施形態による積層チップの断面構成を示す図面である。

【図9】この発明の他の実施形態による積層チップの断面構成を示す図面である。

【図10】この発明の他の実施形態による積層チップの 10 断面構成を示す図面である。

【図11】この発明の他の実施形態による積層チップの 分解斜視図である。

【図12】コンパクトディスクシステム60の構成を示す機能ブロック図である。

【符号の説明】

2 · · · · · · L S I

4・・・・・・・ 積層チップ

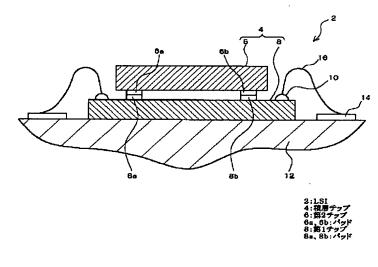
6・・・・・・・第2チップ

6a, 6b・・・パッド

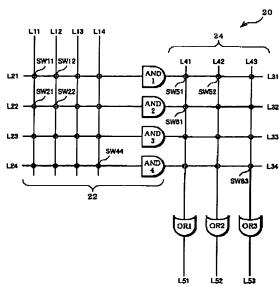
20 8・・・・・・・第1チップ

8a, 8b・・・パッド

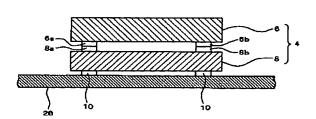
【図1】

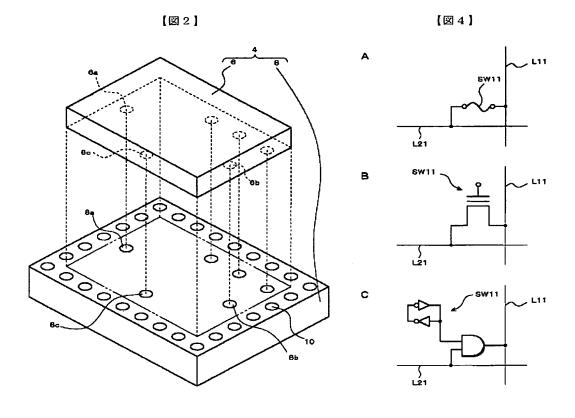


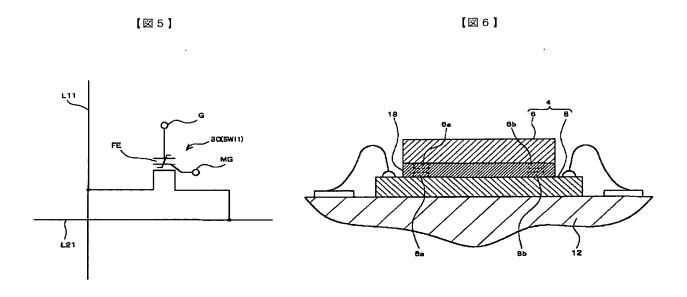
【図3】



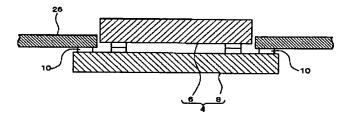
【図8】



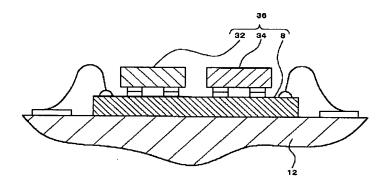




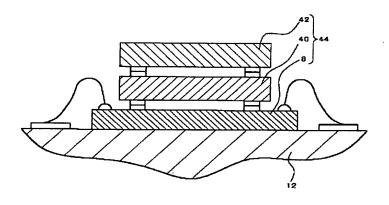
【図7】



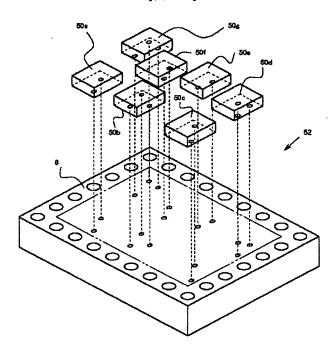
[図9]



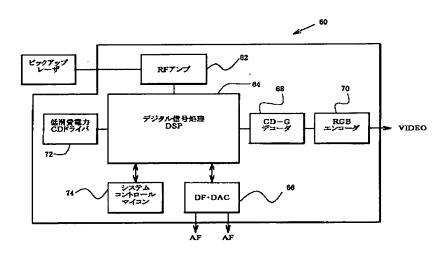
[図10]



【図11】



【図12】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶

識別記号

FΙ

H O 3 K 19/173 1 O 1